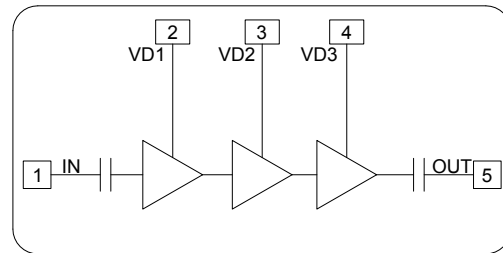


特点:

- 频率: 30~40GHz
- 增益: 24dB
- 输出-1dB 压缩点: 10dBm
- 单电源工作: +2.5V@75mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.9×0.96×0.1mm

功能框图

性能参数: (TA=+25℃, VD=+2.5V, ID=75mA)

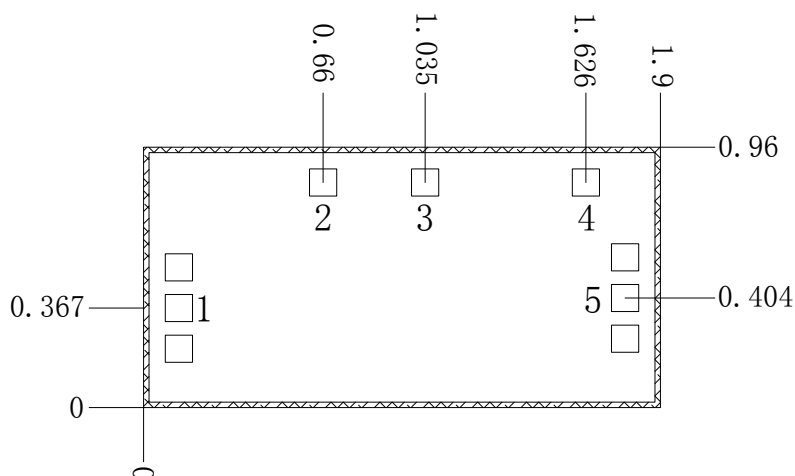
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+2.5V Zin=Zout=50Ω	30		40	GHz	
增益	G			24		dB	
增益平坦度	ΔG		2	3	dB		
噪声系数	NF		2	3	dB		
输入驻波	VSWRi		1.7	2.5			
输出驻波	VSWRo		1.7	2.5			
输出 P ₋₁	P ₋₁		9	10		dBm	
电流	ID	VD=+2.5V		75	90	mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+3	V	最大输入功率	+20	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

芯片尺寸图:

单位: mm

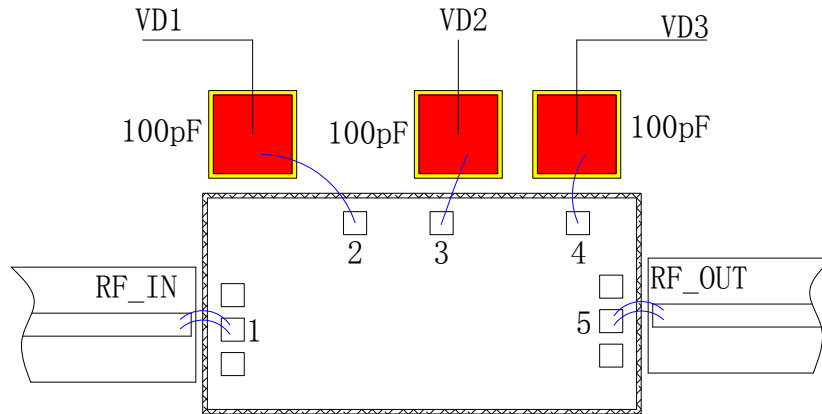


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

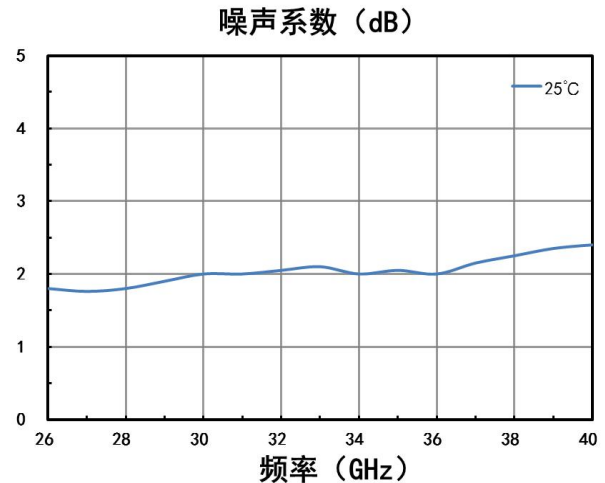
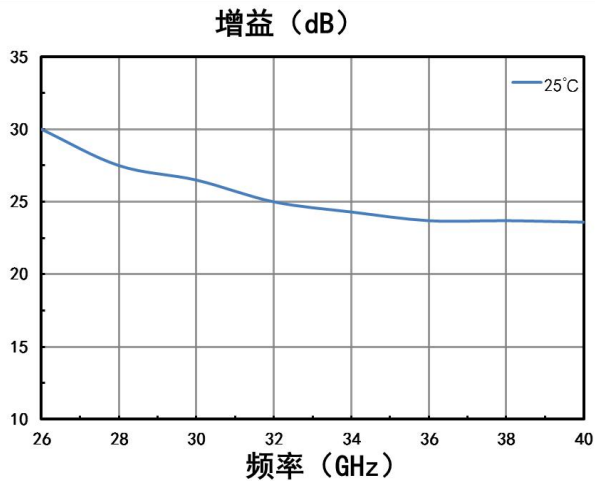
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2, 3, 4	VD1, VD2, VD3	放大器电源电压，需外接 100pF 旁路电容
5	OUT	射频输出，AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

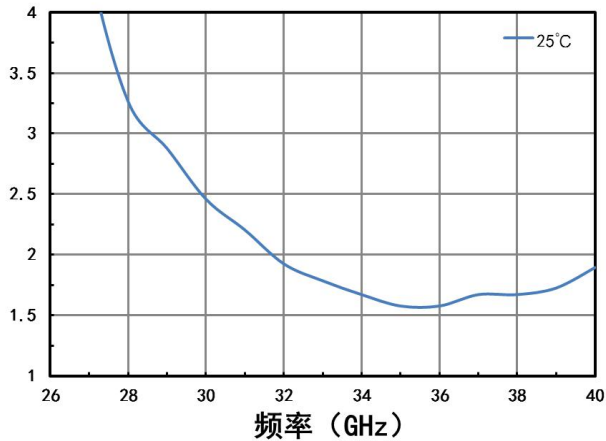
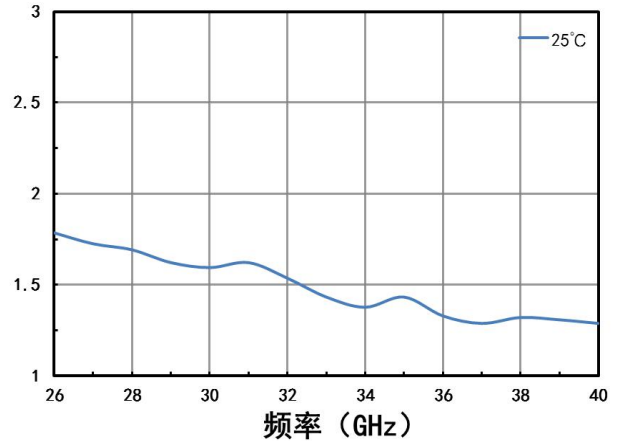
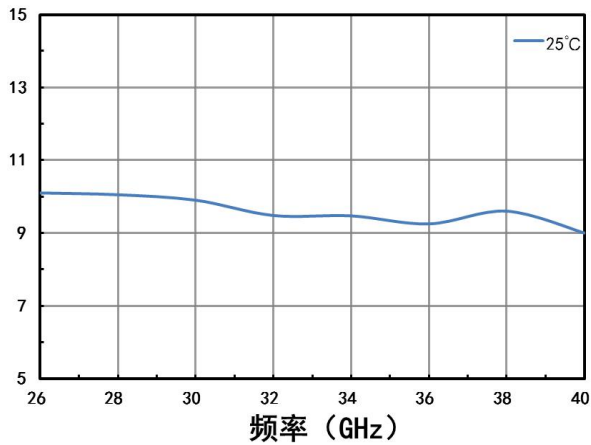
推荐装配图：



注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：



输入驻波比

输出驻波比

输出P-1dB (dBm)


产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。